

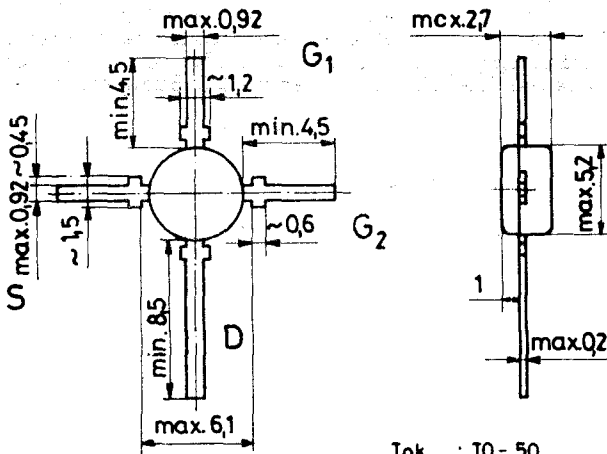
M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT

IV., Fóti út 56.

1325 Budapest, Pf. 21 Telefon: 691-100 Telex: 22-7306

BF 966 N-csatornás két Gate-es MOS térhatású kiűritéses módú tetróda

Méreték mm-ben



Tok : T0-50
Tömeg: kb 0,1g

Ajánlott alkalmazás:

UHF hangoló egység bemenő- és keverőfokozatába.

Jellegzetes tulajdonságok:

Gate-et védő diódák beépítve.

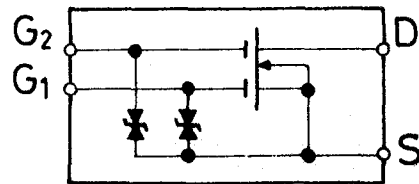
Nagy keresztmoduláció feldolgozás.

Alacsony zajtényező.

Nagy AGC átfogási tartomány.

Kicsi visszaható kapacitás.

Kicsi bemenő kapacitás.



MAXIMÁLIS HATÁRADATOK	JELÖLÉS	BF 966	EGYSÉG
Drain-Source feszültség	V_{DS}	20	V
Drain áram	I_D	30	mA
1-es és 2-es Gate által vezérelt Source áram csúcserő	$\pm I_G$ 1/2 DM	10	mA
Teljes teljesítménydisszipáció $T_{amb}=60^\circ C$	P_{tot}	200	mW
Csatorna hőmérséklete	T_C	150	$^\circ C$
Tárolási hőmérséklet	T_{stg}	- 55 ... + 150	$^\circ C$
HŐELLENÁLLÁS			
csatorna és környezet között 40x25x1,5mm egy oldalán 35 μm Cu fóliás nyomtatót áramköri lapra szerelve	R_{thCA}	450	K/W

STATIKUS JELLEMZŐK $T_{amb}=25^{\circ}C$ ha másként nincs meghatározva	JELÖLÉS	BF 966	EGYSÉG
Drain-Source letörési feszültség $I_D=10\mu A, -V_{G1S}=-V_{G2S}=4V$	$V_{(BR)DS}$	≥ 20	V
1-es Gate-Source letörési feszültség $\pm I_{G1S}=10mA, V_{G2S}=V_{DS}=0$	$\pm V_{(BR)G1SS}$	$\geq 6, \leq 20$	V
2-es Gate-Source letörési feszültség $\pm I_{G2S}=10mA, V_{G1S}=V_{DS}=0$	$\pm V_{(BR)G2SS}$	$\geq 6, \leq 20$	V
1-es Gate-Source visszáram $\pm V_{G1S}=5V, V_{G2S}=V_{DS}=0$	I_{G1SS}	≤ 50	nA
2-es Gate-Source visszáram $\pm V_{G2S}=5V, V_{G1S}=V_{DS}=0$	I_{G2SS}	≤ 50	nA
Drain áram $V_{DS}=15V, V_{G1S}=0, V_{G2S}=4V$	I_{DSS}	≤ 20	mA
1-es Gate-Source zárófeszültség $V_{DS}=15V, V_{G2S}=4V, I_D=20\mu A$	$-V_{G1S(OFF)}$	$\leq 2,5$	V
2-es Gate-Source zárófeszültség $V_{DS}=15V, V_{G1S}=0V, I_D=20\mu A$	$-V_{G2S(OFF)}$	$\leq 2,0$	V

DINAMIKUS JELLEMZŐK $U_{DS}=15V, I_D=10mA, V_{G2S}=4V, f=1MHz$ $T_{amb}=25^{\circ}C$ ha másként nincs megadva	JELÖLÉS	BF 966	EGYSÉG
Meredekség	Y_{fs}	$\geq 15, 17$	mS
1-es Gate bemenő kapacitása	C_{iSSg1}	$2,2 \leq 2,6$	pF
2-es Gate bemenő kapacitása $V_{G1S}=0, V_{G2S}=4V$	C_{iSSg2}	1,1	pF
Visszaható kapacitás (G és S földelve)	C_{rSS}	$25; \leq 35$	pF
Kimenő kapacitás	C_{oSS}	$0,8; \leq 1,2$	pF
Teljesítmény erősítés $g_G=2mS, g_L=0,5mS, f=200MHz$ $g_G=33mS, g_L=1mS, f=800MHz$	G_{ps} G_{ps}	25 18	dB dB
Zajtényező $V_{DS}=15V, I_D=10mA, f=200MHz$ $V_{G2S}=4V, g_G=2mA, f=800MHz$	F F	1,0 2,3	dB dB

Schronk László

Bármely alkalmazástechnikai kérdésben a MEV Félvezető Ágazat Fejlesztése készséggel áll felhasználónk rendelkezésére (Telefon: 692-800/2337).



M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT